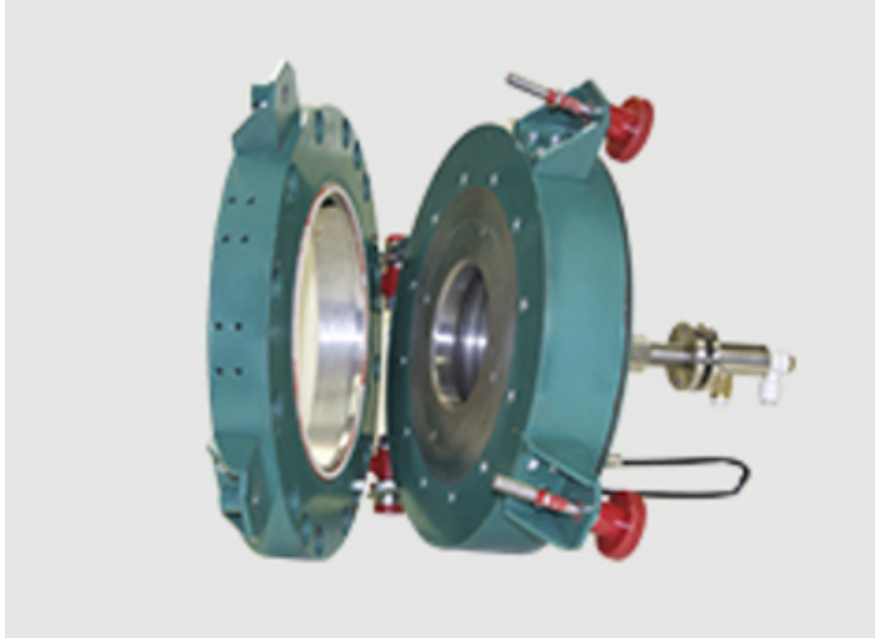


РАСПЫЛЯЮЩИЙ ИОННЫЙ ИСТОЧНИК НА ОСНОВЕ УСКОРИТЕЛЯ С АНОДНЫМ СЛОЕМ SPIS-002



Екатеринбург, Россия

НАЗНАЧЕНИЕ

Распыляющий ионный источник на основе ускорителя с анодным слоем SPIS-002 предназначен для формирования тонких пленок металлов, полупроводников и диэлектриков методом ионно-лучевого распыления и реактивного ионно-лучевого распыления.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ионно-лучевое распыление
реактивное ионно-лучевое распыление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр мишени, мм 80
Анодное напряжение DC, В 800...6000
Энергия ионов, эВ 300...2000
Ток разряда, мА до 300
Ток ионного пучка, мА до 250
Рабочее давление, Па 0, 01...0, 06
Расход газа, мл/мин до 40
Рабочие газы Ar, O₂, N₂, CH₄ и т.д.
Скорость нанесения слоев (A1), нм/с до 0, 8
Размеры, мм Ø 307x296
Масса, кг, не более 12

ПРЕИМУЩЕСТВА

ионный источник позволяет распылять металлические, полупроводниковые и диэлектрические (SiO₂, TiO₂, BN и т.д.) мишени в качестве источника магнитного поля используется электромагнит, что позволяет оптимизировать индукцию магнитного поля в канале ускорения и повысить эффективность формирования ионных пучков

оригинальная конструкция фланцевого крепления и съемного мишенного блока ионного источника обеспечивает легкий доступ оператора для смены мишеней и очистки мишеней источников

для формирования многослойных структур в едином вакуумном цикле ионный источник может оснащаться вращаемым мишенедержателем с четырьмя мишенями из различных материалов

возможность переделки распыляющего ионного источника в ассистирующий путем замены деталей разрядной зоны и установки мишенного блока
использование смесей инертных и реактивных газов (кислород, азот и т.д.) позволяет получать компонентные пленки при распылении металлических мишеней

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Бел. гос. универ. информатики
и радиоэлектроники Научно-
исследовательская часть**

+37517 293 80 55

ул. П. Бровки, 6